

## 已经授权专利

1. 肖长江, 靳常青, 王晓慧, 高密度纳米陶瓷的制备方法, 专利号: ZL200410083676.8, 专利授权时间: 2006.4.12
2. K·麦登, 余勇, 靳常青, 交流磁化率测量用压力胞及其施压装置和交流磁化率测量系统, 专利号: ZL200710176823.X, 专利授权时间: 2009.12.2
3. 刘青青, 杨华, 杨留响, 余勇, 禹日成, 李凤英, 靳常青, 一种提高顶角氧掺杂高温超导转变温度的方法, 专利号: ZL200810057513.0, 专利授权时间: 2009.12.30
4. 朱金龙, 李凤英, 靳常青, 低温高压下样品的介电常数和介电损耗测量装置及方法, 专利号: ZL200810117329.0, 专利授权时间: 2010.6.23
5. 余勇, 杨留响, 靳常青, 高压实验用振动式交流磁信号探测系统, 专利号: ZL200810055937.3。 专利授权时间: 2010.8.11
6. 靳常青, 刘青青, 赵景庚, 一种立方钙钛矿结构  $\text{BaRuO}_3$  晶体及其制备方法, 专利号: ZL200810057519.8, 专利授权时间: 2010.09.29
7. 龙有文, 杨留响, 靳常青,  $\text{Sr}_{1-x}\text{Ca}_x\text{CrO}_3$  钙钛矿莫特化合物及其高压高温合成方法, 专利号: ZL200810057515.X, 专利授权时间: 2010.9.29 无效
8. 赵景庚, 杨留响, 靳常青, 一种“6H”- $\text{BaIrO}_3$  晶体及其制备方法, 专利号: ZL200810057520.0, 专利授权时间: 2010.9.29
9. 游淑洁, 陈良辰, 靳常青, 一种金刚石对顶压砧充气装置, 专利号: ZL201120023620.9, 专利授权时间: 2011.8.3
10. 靳常青, 望贤成, 刘青青, 吕玉玺, 高伟波, 杨留响, 李凤英, 禹日成, 一种铁基高温超导晶体及其制备方法, 专利号: ZL200910077293.2, 专利授权时间: 2012.3.21
11. 朱金龙, 冯少敏, 王丽娟, 刘青青, 李凤英, 靳常青, 一种多铁材料  $\text{Bi}_2\text{NiTiO}_6$  的磁性能和铁电性能的调控方法, 专利号: ZL201010164815.5; 专利授权时间: 2012.9.5
12. 邓正, 靳常青, 望贤成, 一种磁电功能材料及其制备方法, 专利号: ZL201010117666.7, 专利授权时间: 2012.10.3
13. 吕玉玺, 刘青青, 靳常青, 6H 相钙钛矿  $\text{BaCrO}_3$  晶体及其制备方法, 专利号: ZL201010281020.2, 专利授权时间: 2013.4.17
14. 吕玉玺, 刘青青, 靳常青, 一种掺杂 Mott 化合物晶体及其制备方法, 专利号:

ZL201110127442.9, 专利授权时间: 2013.6.5

15. 于润泽, 望贤成, 孔盼盼, 刘青青, 靳常青, 一种超高压新相  $\text{Cu}_2\text{Sb}$  合金晶体及其制备方法, 专利号: ZL201210074831.4, 专利授权时间: 2013.10.30
16. 朱洁, 刘青青, 靳常青, 碲化银晶体及其制备方法, 申请日: 2012年5月15日, 授权公告日: 2014年12月24日, 专利号: ZL 201210150810.6
17. 陈碧娟, 邓正, 靳常青, 一种半导体材料  $\text{BaF}_x\text{ZnAs}$  及其制备方法, 申请日: 2013年10月11日, 授权公告日: 2016年5月3日, 专利号: ZL 201310119534.1
18. 邓正、靳常青, 一种铁磁半导体材料  $\text{Li}(\text{Zn}, \text{Mn})\text{P}$  及其制备方法, 申请日: 2013年10月9日, 授权公告日: 2016年4月21日, 专利号: ZL 201310091221X
19. 靳常青, 赵侃, 邓正, 一种稀磁半导体材料  $(\text{Ca}, \text{Na})(\text{Zn}, \text{Mn})_2\text{As}_2$  及其制备方法, 申请日: 2014年06月27日, 授权公告日: 2017年07月21日, 专利号: ZL201410302565.5
20. 赵侃, 邓正, 靳常青, 一种稀磁半导体材料及其制备方法, 申请日: 2012年12月31日, 授权公告日: 2017年07月21日, 专利号: ZL201210593000.8
21. 靳常青, 陈碧娟, 邓正, 一种稀磁半导体材料  $(\text{Sr}, \text{Na})(\text{Zn}, \text{Mn})_2\text{As}_2$  及其制备方法, 申请日: 2014年05月14日, 授权公告日: 2018年03月02日, 专利号: ZL201410201977.X